電子制御工学科 平成22年度

電子制御工学科 平成22年度								
科目名	半導体工学 Semiconductors			担当教員	清水 共			
学 年	4年	学 期		履修条件	必修	単位数	2	
分 野	専門	授業形式	講義	科目番号	10C04_30610	単位区別	履修	
学習目標	集積回路に関する基礎的な知識を得ておくことは、現代のあらゆる技術分野において必須である。本講義では集積回路を構成するデバイスであるダイオード、トランジスタの基本構造と動作原理の理解を深めると共に、これらの製造プロセスについて基本的な部分を理解する。 講義を中心として行う。講義で学んだことを演習・レポートにより復習し習熟度を高める。							
進め方								
学習内容	学習項目(時間数)				学習到達目標			
	 ガイダンス,量子物理学と古典物理学(2) 電子の波動性1(2) 電子の波動性2(2) 水素原子のエネルギー準位(2) 量子数(2) パウリの排他律,軌道と電子状態(2) 固体中の価電子の振舞い(2) 				電子の波動性を理解し、固体のエネルギー準位図を理解する。D2:1			
	[前期中間試験](2)							
	 8. 答案返却・解答,結晶構造(2) 9. 導体・絶縁体・半導体,バンド構造(2) 10. 真性半導体と不純物半導体(2) 11. 不純物半導体(2) 12. 移動度(2) 				半導体の電気伝導の機構を理解する。D2:2			
	13. フェルミ・ディラックの分布関数(2) 14. 自由電子近似,キャリア濃度(2) 前期末試験				フェルミ準位,フェルミ分布関数を理解する。 D2:1			
	15. 答案返却・解答(2) 16. フェルミ準位(2) 17. ホール効果(2)			真性半導 D2:2	PN 接合の物理的な性質を理解し、電気的特性を理解する。D2:2			
	18. PN接合(4) 19. 逆方向飽和電流(2) 20. 降伏現象(2) 21. バイポーラトランジスタ 1(2) [後期中間試験] (2)							
	22. 答案返却・解答(2)23. バイポーラトランジスタ 2(2)24. FET(2)			1 1	トランジスタの動作をエネルギー帯理論により説明できる。D2:3 集積回路の意義,作製方法の概略を理解する。D2:1 半導体光デバイスの基本的な動作原理を理解する。 D2:1			
	25. MOSFET のバンド構造と動作メカニズム(2) 26. 集積回路(2) 27. IC の製造工程(2) 28. 半導体の光学的性質(2) 後期末試験			半導体光				
	29. 答案返却・解答(2)							
評価方法	定期試験 70% ,レポート・演習等 30% の比率で総合評価する。							
履修要件	特になし							
関連科目	電子回路 I , II							
教 材	教科書:渡辺秀夫著「半導体工学」コロナ社							
備考	特になし							